專利權讓與公告：

介電質材料形成平台側壁的半導體製造方法及其半導體元件 (US 9076650)

公告主旨	專利權讓與遴選廠商公告： 介電質材料形成平台側壁的半導體製造方法及其半導體元件 (US 9076650)
公告時間	109 年 4 月 13 日
公告內容	一、 專利權家族名稱： 介電質材料形成平台側壁的半導體製造方法及其半導體元件 / Method For Fabricating Mesa Sidewall With Spin Coated Dielectric Material And Semiconductor Element Thereof 1. 美國專利證書號 US 9,076,650 二、發明人：綦振瀛教授 (電機工程學系)、王聖瑜、紀駿邦 三、廠商資格： 1.產業類別：電子與光電工程-矽基半導體技術 2.應具備之專門技術：電子與光電工程 3.應有之機具設備：無 4.應有之研究或技術人員：電子與光電工程相關技術人員 5.其他條件：無特殊限制 6.其餘應符合本校技術移轉相關規定。 四、申請方式：逕向研發處智權技轉組詢問相關資訊。 五、申請截止日期：108 年 4 月 24 日 17 時 00 分止
聯 絡 人	研發處產學營運中心智權技轉組 鄭經理
聯絡電話	03-4227151 轉 27077
電子郵件	johnny@g.ncu.edu.tw

專利摘要資料：

1. US 9076650：http://ipm.ncu.edu.tw/prod1.asp?ser=17730